

Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ243-630-22

Средний прямой ток	I_{TAV}	630 A
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	2000 ÷ 2200 V
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	
Время выключения	t_q	32.0 мкс
U_{DRM} , U_{RRM} , В	2000	2200
Класс по напряжению	20	22
T_j , °C		- 60 ÷ 125

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	A	630 850	$T_c=80$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=55$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	A	989	$T_c=80$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	kA	10.0 11.5	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс
			11.0 13.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2\cdot 10^3$	500 660	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс
			500 700	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	2000÷2200	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	2100÷2300	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	V	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	A	8	$T_j = T_{j\ max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	V	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	A/мкс	2000	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$; $U_G = 20$ V; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ A/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	- 60 ÷ 125	
T_j	Температура р-п перехода	°C	- 60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	14.0÷16.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии			
U_{TM}	V	2.30	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 1978$ A
$U_{T(to)}$	V	1.20	$T_j = T_{j\ max}$; $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
r_T	МОм	0.65	
I_H	mA	500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ V; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики			
I_{DRM}, I_{RRM}	mA	100	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	V/мкс	1000	$T_j = T_{j\ max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления

U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	4.00 2.50 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 V; I_D = 3 A;$ Постоянный ток управления
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.25	$T_j = T_{j \max}$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$	
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	10.00		Постоянный ток управления

Динамические характеристики

t_{gd}	Время задержки включения	мкс	2.5	$T_j = 25^\circ C; V_D = 0.4 V_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV}$ Gate pulse: $I_G = I_{FGM}$; $V_G = 20 V$ $t_{GP} = 50 \mu s$; $di_G/dt = 1 A/\mu s$	
t_q	Время выключения ²⁾ , макс	мкс	32.0	$dv_D/dt = 50 V/\mu s$	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV}$
			40.0	$dv_D/dt = 200 V/\mu s$	$di_R/dt = -10 A/\mu s$ $U_R = 100 V$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	350		
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	5.0		
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	А	155		

Тепловые характеристики

R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^\circ C/Vt$	0.0340	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.0748		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.0612		Охлаждение со стороны катода
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^\circ C/Vt$	0.006	Постоянный ток	

Механические характеристики

w	Масса, тип	г	280				
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	27.6 (1.087)				
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	16.0 (0.630)				

ПРИМЕЧАНИЕ

¹⁾ Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии

Обозначение группы	A2
$(dv_D/dt)_{crit}, V/\mu s$	1000

²⁾ Время выключения ($dv_D/dt = 50 V/\mu s$)

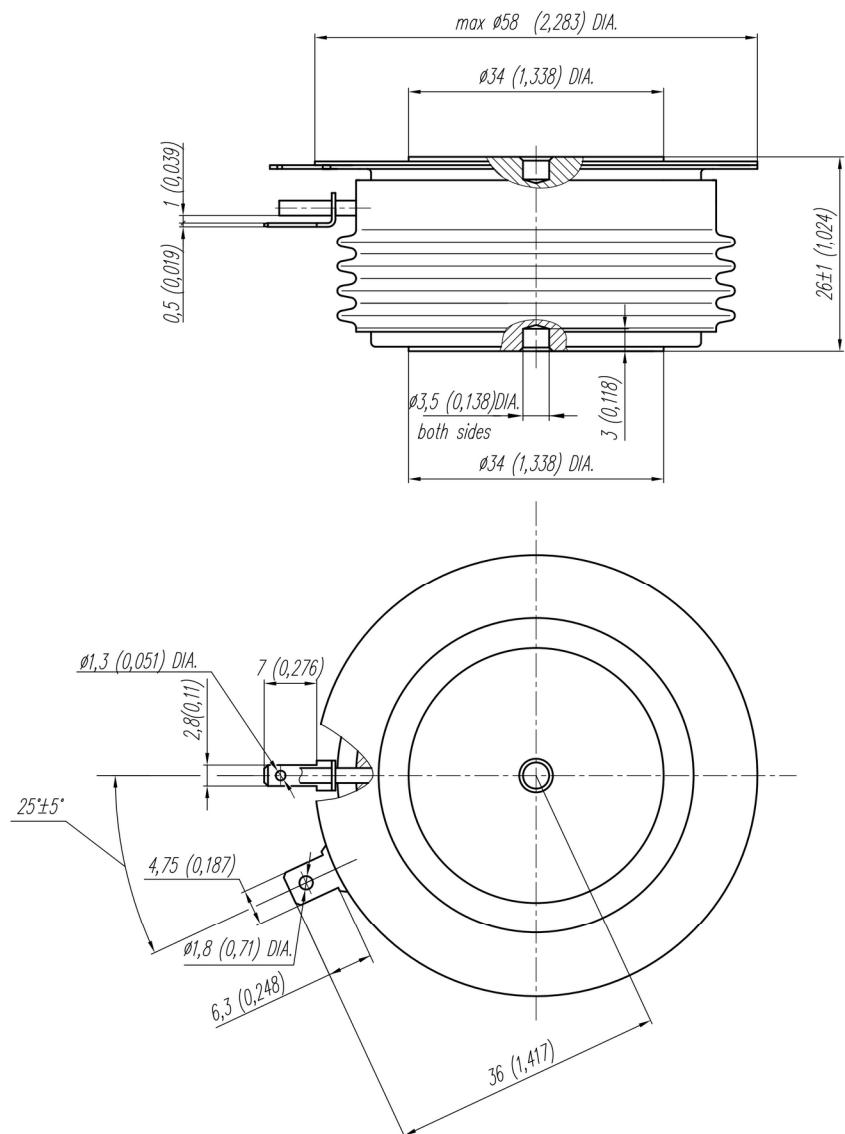
Обозначение группы	K3
$t_q, \mu s$	32.0

МАРКИРОВКА

ТБИ	243	630	22	A2	K3	УХЛ2
1	2	3	4	5	6	7
1.	Быстродействующий импульсный тиристор					
2.	Конструктивное исполнение					
3.	Средний ток в открытом состоянии, А					
4.	Класс по напряжению					
5.	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии					
6.	Группа по времени выключения ($dv_D/dt = 50 V/\mu s$)					
7.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т					

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: Т.С3



Все размеры в миллиметрах (дюймах)